

MGT/MJT 1A1Bシリーズ 小型SMT

本シリーズは、マーク接点2本を使用し片側1本を自己保持させ、トランスマウント構成を確立した弊社独自技術(1A+1B)をサーフェスマウント化した製品です。マーク接点を採用することで寿命が6倍に伸び、高信頼性を実現し、半導体自動検査装置業界や計測器業界から高い評価を受けております。



<特長>

- 実装面積 : MGT-E1□□ /12.7mm x 7.62mm
MJT-E1□□ /10.8mm x 7.62mm
- 電気的寿命 : 3億回(at 1V 10mA)
- 絶縁抵抗 : $10^{11}\Omega$ 以上
- 周波数特性 : DC ~ 2.5GHz (インサーションロス-1dB typ.)

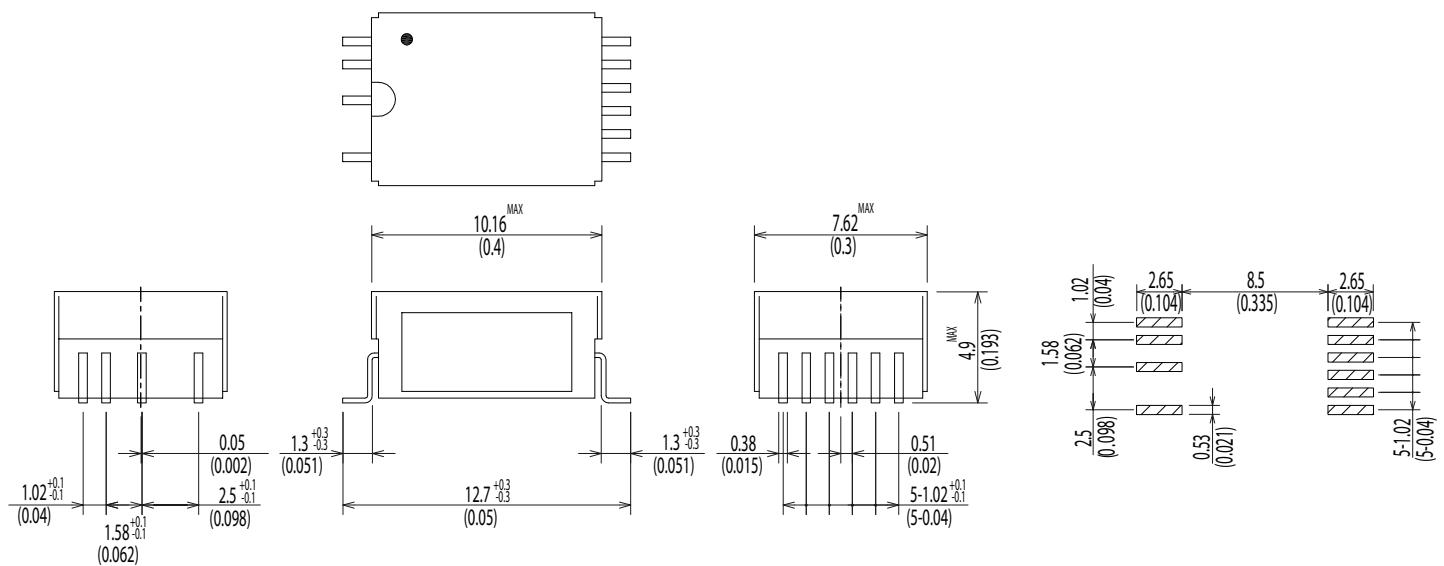


MGT/MJT 1A1B		MGT-E103H	MGT-E105H	MGT-E112H	
仕様項目	単位	MJT-E103H	MJT-E105H	MJT-E112H	
コイル仕様			1 Form C(A+B)		測定条件
接点仕様					
最大開閉電圧	VDC	3.3	5.0	12.0	
コイル抵抗	Ω	70	110	550	$\pm 10\%$ @ 20°C
動作電圧	VDC Max	2.8	3.75	8.8	@ 20°C
復帰電圧	VDC Min	0.5	0.7	1.2	@ 20°C
製品規格					
絶縁抵抗	Ω Min	10 ¹¹		Between all isolated pins @ 100V 20°C 65%RH	
絶縁耐圧 (静的耐圧)	VDC Min	200		Between contacts	
	VDC Min	250		Contacts to shield	
	VDC Min	250		Contacts to coil	
	VDC Min	250		Shield to coil	
動作時間 (バウンス含む)	msec Max	0.5		@nominal coil voltage	
復帰時間	msec Max	0.5		100Hz square wave	
				Diode suppression	
測定標準状態		環境条件			
温度: 15°C to 35°C 湿度: 25% to 75%RH 気圧: 860 to 1060hpa		保存温度範囲: -40°C to +85°C 使用温度範囲: -20°C to +60°C 振動: 20G's to 2000Hz 衝撃: 50G's リフロー条件: 260°C max, 60秒以内			

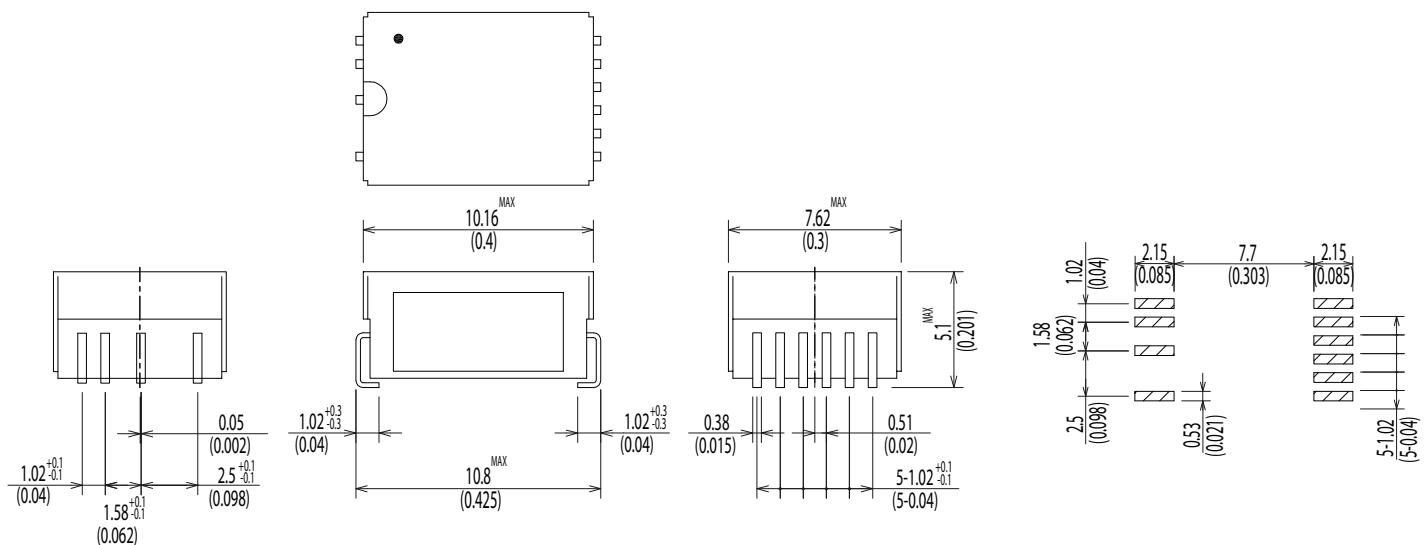
Dimensions All Dimensions are mm (inch)

Land Pattern Recommendation

MGT-E103H/MGT-E105H/MGT-E112H

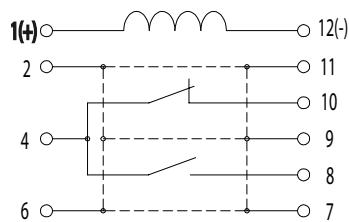


MJT-E103H/MJT-E105H/MJT-E112H



Schematic <Top View>

MGT-E103H/MGT-E105H/MGT-E112H



MJT-E103H/MJT-E105H/MJT-E112H

